

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 53-060582

(43)Date of publication of application : 31.05.1978

(51)Int.CI. H01L 27/04
H01L 29/68

(21)Application number : 51-135340 (71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 12.11.1976 (72)Inventor : OKABE TAKAHIRO
KANEKO KENJI
NAKAMURA TORU

(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the density of integration and also increase gm by forming a MOSFET and a bipolar transistor in integral structure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

⑨日本国特許庁

⑩特許出願公開

公開特許公報

昭53-60582

⑪Int. Cl.
H 01 L 27/04
H 01 L 29/68

識別記号

⑫日本分類
99(5) E 0 7514-57
99(5) E 2 7514-57
99(5) E 3 6603-57
99(5) H 0 6513-57

⑬公開 昭和53年(1978)5月31日
発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭半導体集積回路装置

⑮特 願 昭51-135340

⑯出 願 昭51(1976)11月12日

⑰發明者 岡部隆博
国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番
地 株式会社日立製作所中央研
究所内
金子憲二
国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番

同

地 株式会社日立製作所中央研
究所内

⑱發明者 中村徹

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番
地 株式会社日立製作所中央研
究所内

⑲出願人

株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目5
番1号

⑳代理 人 弁理士 薄田利幸

明細書

発明の名称 半導体集積回路装置

特許請求の範囲

第1の不純物形半導体基板上に形成された
FETの第2の不純物形半導体からなるドレイン
領域をトランジスタのベース領域と一体化し、上
記FETの上記基板を上記トランジスタのコレクタ
領域と一体化し、かつ上記FETのソース領域
と上記基板は電極で接続して一方の電位端子とし、
上記トランジスタの上記ベース領域中に設けられ
た第1の不純物形半導体からなるエミッタ領域を
他方の電位端子とし、上記FETのゲート電極を
入力端子として構成したことを特徴とする半導体
集積回路装置。

発明の詳細な説明

本発明は半導体装置、くわしくはMOS
(Metal Oxide Semiconductor)素子とバイポー
ラ素子とを組み合わせた高能率の電圧・電流交
換半導体装置に関するものである。

従来、演算増幅回路などの差動入力部には高増

幅率のバイポーラ・トランジスタか、電圧入力形
のMOSもしくは接合形FET(Field Effect
Transistor)を用いることが多かつた。これは、
演算増幅器としては入力電流が選択的には零であ
る高入力インピーダンス特性が必須だからである。
しかるに、バイポーラ・トランジスタでは原理的
に入力電流を必要とし、1mA以下にはしがたい
欠点を持つている。また一方において、MOSも
しくは接合形のFETでは、チャネル・コンダク
タンス(以下記号的に μ と略す)を高くとること
ができる、FETだけで演算増幅器を組むと十
分な電流、もしくは電圧利得を得ることができ
ない。これを解消するため、従来は入力の差動対ト
ランジスタだけを入力インピーダンスの高い
FETとし、これと独立に形成したバイポーラ・
トランジスタなどを組み合せて増幅回路を形成して
いた。このため、別々にFETとバイポーラ素子
を形成して回路を構成するため、集積回路とした
時のチップ上の面積が増大するという欠点を持つ
ていた。

BEST AVAILABLE COPY

本発明は従来のかかる欠点を改善するためになされたもので、小面積でかつ大きさを取れるようにしたMOSとバイポーラの複合構造を提供するものである。

第1図に本発明の概念を説明するための半導体装置の断面構造を示し、第2図にその等価回路を示す。すなわち、第1図において、N層1の上に設けたN層2の表面部にP層3、4を構成し、このP層間はS10₁層8を介して金属層10が存在し、これらでPチャネルMOS・FETが形成されている。他方、P層3にはさらK N層5を設け、このN層5とP層3と、N層1、N層2によりNPNトランジスタが形成されている。いま、P層4と、N層2のオーミックコンタクト用N層6とを電極9で結合した状態を考える。電極9を高電位に、電極11を低電位にしておき、電極端子10（以下この端子をゲート端子と仮称する）に入力電圧を印加する。ゲート端子10の電圧が端子9（以下ソース端子と仮称する）の電位と同電位のときはP層3（この場合はドレイン

に相当する）には電流が流れない。これは通常のPチャネルMOS・FETの特性より導出されるものである。ゆえにP層3を前記のNPNトランジスタのベースとみると、ベースに電流が供給されないことを意味し、NPNトランジスタはオフとなり、ソース端子9もNDNのエミッタ端子11にも電流は流れない。つぎにゲート端子10の電位をソース端子9の電位より、閾値電圧V_{TB}以下に下げると、PチャネルMOS・FETはオンとなり、そのドレンであるP層3に電流が流れ込む。これはNDNトランジスタのベースに電流が流れることと等価となるため、このベース電流の電流増幅率β倍の電流が電位9からN層2、N層1を通してそのエミッタ端子11に流れる。ゆえに、MOS・FETのわずかなドレン電流がNPNトランジスタによって増幅され、全体を1つのMOS・FETとみると、従来にない高いβを持つFETが実現されたと考えられる。また、全体を1つのバイポーラ・トランジスタみると、ゲート端子10が入力のベース端子に相当

するので、電流増幅率が無限大の、いわば入力インピーダンスの高いバイポーラ・トランジスタとみるととも出来る。

さて、第2図の等価回路を使って動作時のこの複合構造のトランジスタの等価チャネルコンダクタンスG_sを求めるとき、簡単な式の計算から、次式を得る。

$$G_s = g_m \cdot \beta \quad \dots \dots \dots (1)$$

ここでg_mはMOS・FETのチャネル・コンダクタンスであり、βはNPNトランジスタの電流増幅率である。g_m ≈ 20 μA/V、β = 100とすると、G_s ≈ 2000 μA/Vが得られる。従来のMOS・FETでは、g_mを大とするにはW/L（チャネル巾対チャネル長）を大とせざるを得ず、大きさを得るには極めて大きな面積を必要とする欠点がある。本素子構造では、従来とはほぼ同様の面積で100倍以上のg_mを得ることが可能であることを示している。本構造はPチャネルMOSとNPNトランジスタの組み合せで構成されている場合を示したが、PとNの極性および

印加電圧の極性を逆にしても同様の効果が得られることはいうまでもない。なお、製造上MOSの特性をNDNの特性と独立に制御できるようにするには、第1図の7に示す部分に周知のイオン打込み法によつてチャネルの不純物量を制御すればよい。

以下本発明を実施例によつて説明する。

第3図は第1の実施例を示したもので、本発明の素子を従来のバイポーラICの工程で同時に作つたものである。すなわち、P形基板14とアイソレーションP_d膜15によつて本発明の素子と従来のバイポーラ素子とを電気的に分離して形成され、相互配線によつてICが形成される。第4図は第3図の等価な素子を示したものである。

第5図は本発明の素子を第3図に示したような素子形成を経て、底面増幅率の基本部の回路を構成した場合の実施例である。第6図はその記号的に表したブロックを示したものである。さて、第5図において、Q₁、Q₂は本発明による複合素子であり、Q₃、Q₄は通常のバイポーラ素子

BEST AVAILABLE COPY

である。I₁ は通常の素子を用いて回路を構成した定電流源を示している。V_{cc} は電源電圧である。今差動対にされた本発明による複合素子の入力端子に V₁, V₂ なる電位を加えると、もしも V₁ = V₂ ならば、回路のオフセット電圧を無視すると、複合素子 Q₁, Q₂ のエミッタは 1/2 ブラウスの電流が流れれる。Q₁ と Q₂ のベース・エミッタ間ダイオード特性が同じであるように設計されているものとすれば、Q₁, Q₂ のダイオード、もしくはコレクタ電流は相等しいから、V₁ の端子への入、出電流はなく、出力につながる負荷によつて V_{out} の電位は定まる。つぎに、V₁ > V₂ となると、Q₁ のエミッタの方が Q₂ より大きな電流が流れれる。しかし、Q₁ は Q₂ によつて制御されているので Q₁ のエミッタ電流を吸い込むことができず、この差額の電流は V_{out} の端子から外へ流れ出ることになる。このため V_{out} の端子の電圧は前回よりも上昇することになる。V₁ < V₂ のときは上記と逆の状態となる。この V_{out} 端子の外側に適当な電流・電圧変換回路を設ければ、必

特開昭53-60582 (3)

要に応じた演算増幅回路を形成することができる。

第 7 図は第 5 図の四重差動増幅回路の差動対を構成する際の他の実施例を示した平面パターン図である。

第 8 図はその A-A' 面の断面構造模型を示したものである。本実施例は、1つのアイソレーションの中に差動対の複合素子がコンパクトに集成されている。これは、近接して作られるために、差動対として重複な特性の 1つであるオフセット電圧値を小さくすることに役立つ。すなわち、集積密度が高く、入力インピーダンスが高く、オフセット電圧は小さく、チャネルコンダクタンスの大きい差動対素子が出来る特徴を持つていることがわかる。

第 9 図は他の実施例を示す。本発明の複合素子の等価チャネルコンダクタンスをさらに大きくするためのもので、NPN のゲーリントン接続素子と P-MOS を一体に組み合せた構造のものである。等価チャネルコンダクタンス G_o は次式のようになる。

$$G_o = g_m \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

ここで g_m は MOS・FET 部のチャネル・コンダクタンス、β₁, β₂ は、NPN パークス部 13, 26 の電流増幅率である。例えば、g_m = 20 μA/V, β₁ = 100, β₂ = 100 とすると、G_o = 0.2 μA/V となる。すなわち、従来の 10000 倍の大きなチャネルコンダクタンスが得られる。

以上説明した如く、本発明によれば、MOS・FET とバイポーラトランジスタを一体構造としたことにより、集積密度が高く、高い g_m を容易に得ることが出来、高性能演算増幅器等への応用においても極めて有用であり、工業上利益をもたらすものと考える。

図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の概念を説明するための断面構造模型図、第 2 図はその等価回路を示す図、第 3 図は本発明の一実施例を示すバイポーラ型集積回路の断面構造模型図、第 4 図はその素子の等価回路を示す図、第 5 図は本発明の素子を用いて使つ

た演算増幅器の基本部をなす差動増幅回路図、第 6 図はそのブロック図、第 7 図は本発明の素子を差動対にした集積回路向き装置の平面図、第 8 図はその A-A' 面の断面構造模型図、第 9 図は本発明の他の実施例図、第 10 図はその等価回路図である。

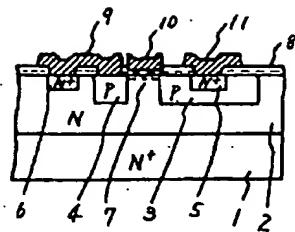
図において、1, 2, 5, 6, 18, 25 は N 形半導体、3, 4, 14, 15, 16, 17, 24 は P 形半導体、8 は SiO₂、7 は MOS 部のチャネル開値電圧制御用イオン打込み層を示す。

代理人弁理士 塚田利幸
平井泰子

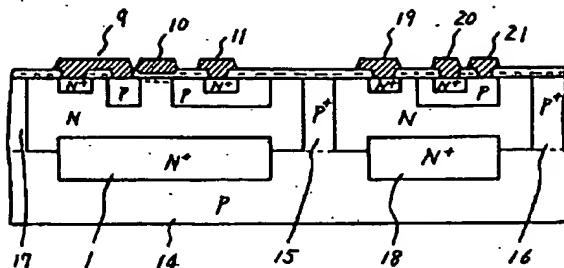
BEST AVAILABLE COPY

特開昭53-60582 (4)

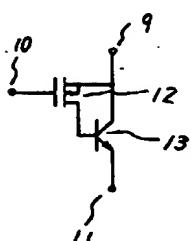
第1図



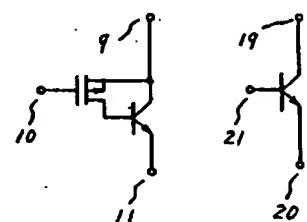
第3図



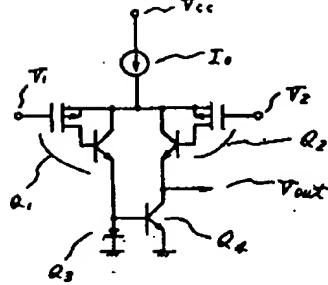
第2図



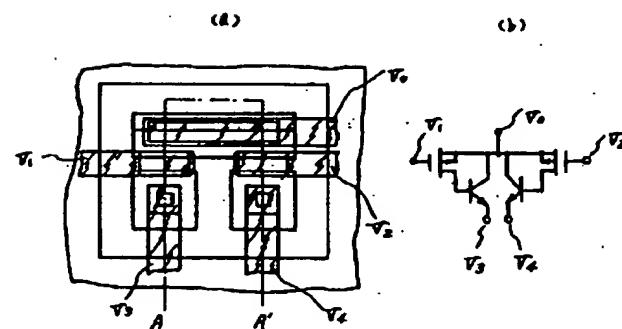
第4図



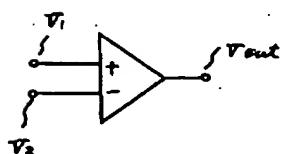
第5図



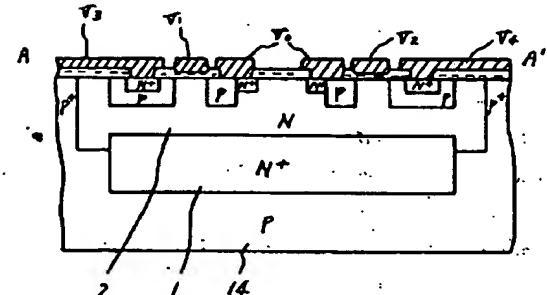
第7図



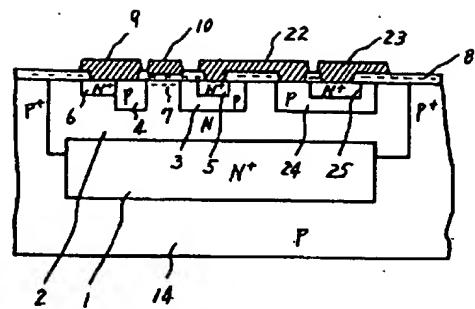
第6図



第8図



第9図



第10図

